機械的損傷とエキソ電子放出

原稿受付 1981 年 9 月 9 日 "調 滑"第 27 巻 第 6 号 (1982) 407~412

重	Л	秀	実
兵	藤	申	_
		東京大学	ドビン部
(〒113	東京都文京区;	本郷七丁目	301)

1. はじめに

我々の人間社会では実にさまざまの工業材料がさまざ まの用途に使われている. これらの材料が機械的に破壊 し用途に耐えなくなることは,資源的あるいはエネルギ ー的な意味で常に大問題であるが,原因の 90% 以上は 疲労にあるといわれている. 疲労の初期に現れるひび割 れは,小さく検出しがたい. どのひび割れが最終的な破 壊につながるかを見出すことは非常に困難である. エキ ソ電子 (exoelectron,略して EE)の発見は, フコース ティック・エミッション (AE)と並んで,これらの困難 を打破する一つの可能性を与えたということができる.

EE の放出量は、一般に試料の損傷が進むにつれて増加する傾向がある^{1,2,3)}.したがって、試料の受けた損傷の度合と放出される EE の関係を見出すことにより、試料の内部または表面状態に関する情報を得ることができる.図1の上は光学的に見た AI 合金上の傷の様子で、図の下は対応する EE の放出量を三次元的にトボグラフィで表したものである、山脈状に見えるのが傷の部分で、山の高さが各点における放出量に対応している 図から分かるように、傷の深い中心部では放出量が多い.

2. エキソ電子の要約

EE とは、金属やある種の無機化合物が特別な外部励起も無く自然に放出する電子群、あるいは物質固有の仕事関数より低いエネルギーの励起によって放出する電子群を意味する.これらの電子放出は、物質が機械的損傷や放射線損傷を受けると顕著になる.EE の場合、熱電子、光電子、二次電子などについて従来から知られていた電子放出機構とは、異なる放出機構によるものと考え

られている.

EE の系統的研究を最初に行ったのは、ドイツの物理 学者 KRAMER⁴⁾であり、EE は "クラマー電子"とも呼ば れる.しかし、EE そのものはさらに古く前世紀末、傷



図 1 Al 表面のき裂付近から EE の放出

Mechanical Damages and Exoelectron Emission

By Hidemi SHIGEKAWA and Shin-ichi HYÖDÖ, Faculty of Engineering, the Univ. of Tokyo (3-1 Hongo 7-chome, Bunkyö-ku, Tokyo 113)

- 5 -

407

をつけた Zn が写真乾板を感光させる現象として Russer により見出されていた⁵⁾. その後 1920 年代に登場した ガイガ計数管の初期計数率の異常として, EE が注目さ れ始めた^{6,7)}. これは, 製作されたばかりの計数管が, 最初の数時間もしくは数日間にわたり,不規則ではある が異常に高い計数率を与える現象である. 平常に達した 後でも,計数管の中に新しく加工された金属を入れると 再び計数率は増大する.

EE を発生させる励起要因は SCHARMAN⁸⁾ によると,

1) 電離放射線による固体の励起

- 2) 物理吸着, 化学吸着,
- 3) 機械的処理(ひっかき,こすり,変形など)
- 4) 化学反応
- 5) 相変換(金属凝固,結晶構造変化)
- 6) 焦電物質の分極効果

と分類されている.しかし実際には、これらの要因が単 独に起こることはまれで、種々の要因のからみ合いが放 出機構解明を困難にしている.

EE について研究する場合,自然放出による EE より も,仕事関数以下の低エネルギー励起による放出を観測 するケースが多い.その際は励起方法によって,熱励起 エキソ電子放出(TSEE: thermally stimulated exoelectron emission) と光励起エキソ電子放出(PSEE: photostimulated exoelectron emission)の2通りに区 別される.TSEE は一般に放射損傷の分野で用いられ, 損傷を与えた試料を昇温加熱し,温度一EE 放出量曲線 (グローカーブ)を書かせ、熱ルミネッセンスとの対応 から解析を進めるという方法がとられる^{9~12)}.一方,機 械的損傷に対しては水銀ランプなどの光で試料を励起す る方法,即ち PSEE が主として用いられている.

3. EEの放出機構

EE の放出機構については、まだ決定的な理論は提出 されていないといえる。したがって、ここでは現存する 代表的なモデルを幾つか紹介するにとどめる。 3.1 トラップによるモテル

KRAMER¹³⁾, LEPPER¹⁴⁾, BOHUN¹⁵⁾, HANLE¹⁶⁾, らにより 採用された機構である.即ち, 試料が損傷を受けた際に 生じる格子欠陥が固体のベンドギャップ内に,図2に示 すようなトラップ準位をつくり, EE 放出源になるとい う考えである.GORDON, SCHARMANN¹⁷⁾によると,トラ ップとしてF中心やM中心が考えられている.トラップ に捕えられた電子は、光励起, 熱励起などにより直接ま たはいったん伝導体を経て固体外部へ放出される.



図 2 トラップ,オージェ再結合によるモデル

3.2 オージェ再結合モデル

図2に示すように、トラッブ準位の電子がホールなど の再結合中心と再結合するさいに放出されるエネルギー を、他のトラップ準位電子が吸収して固体外部に放出さ れるというモデルで、BOHUN¹⁸)、KXAMBRE^{19,20}、TOLPYGO ら²¹)により提案された. このような過程は一般にオージ ニ過程と呼ばれる. 再結合中心があらかじめ存在するこ とと、また、欠陥が高密度に存在することが必要とされ るため、 EE 放出を常にこのモデルにより説明すること は難しいが、数十 eV の運動エネルギーを持った電子の 存在を説明できるという特徴がある.

3.3 表面電界によるバンド湾曲モデル

SUJAK ら²²)により提出されたモデルで、GLAEFEKE²³, DRENCKHAN²⁴, らによりさらに進展した、絶縁体の二次 電子放出係数が1より大きいとき、放射線照射により表 面は正,内部は一次電子により負に帯電し固体表面に強 い電場が生じると考える、図3に示すように光励起や熱 励起により伝導帯に上げられた電子はこの電場により十 分に加速されて外部に飛び出してくる、図中のA,B,C,





図 4 き裂内の電界によるモデル23)

D領域は、それぞれA:絶縁体のバルク部分、B:負の 空間電荷領域、C:電荷の無い領域(空のトラップ)、 D:表面の正の電荷層を表す.また H_1 , H_2 はトラップ 準位を、 E_e は放出される EE のエネルギーを表す. 3.4 き裂内の電界によるモデル

SUJAR²⁵⁾ らによる. 試料が変形を受けると,表面酸化 層中にき裂が生じる. このき裂の相対する表面間に図4 に示すような電場が生じ,3と同様に電子が加速され放 出されるというモデルである. 図中の $\vec{E_0}$ がき裂を横切 る強い電場で,Pは光励起エキソ電子が生じると考えら れている,金属-酸化物の混成部分である.

3.5 空孔拡散モデル26~28)

損傷によって生じた試料内の空孔が試料表面に拡散し てゆき、そこで消滅するときに電子にエネルギーを与え るとするモデルである. 空孔の解放エネルギーは普通、 仕事関数より低いので、放出に当たって光子などがさら に関与することが必要になる. 即ち、空孔の解放エネル ギーを E_v 、光子のエネルギーを $\hbar w$ 、仕事関数を W と すれば、 $E_v + \hbar w > W$ のとき放出が起こる. PINBLEY ら は、このモデルを用いて空孔の活性化エネルギーを求め、 5.6 kcal/mol という、まず妥当な値を得ている.

4. 種々の損傷とEE放出

幾つかの代表的な方法で機械的損傷を与えた場合,それに伴う EE 放出の挙動について述べよう.先に触れた ように,この分野では一般に,水銀ランプやハロゲンラ ンプなどの光源にフィルタを組み合わせ,PSEE の観測 が行われる.放出電子の計測には,GM 計数管や二次電 子増倍管が用いられる.

4.1 引っ張り(圧縮)

引っ張り試験に伴う PSEE の観測例を図 5²⁹に示す. 試料は引っ張り試験用高純 度 ア ル ミニウム (ゲージ長 6.3mm, 幅 5 mm, 厚さ 0.25mm)を 500℃ で 1 時間ア







最小ひずみの関係³⁰⁾

ニールし、表面をエッチングしてから、陽極酸化により 表面に厚さ D の酸化量を生じさせたものである. 図は D=45 nm の場合の結果で、実験は 10^{-5} Torr から 6× 10^{-9} Torr の間の幾つかの異なる圧力下で行われた. 図 中の BR は、試料が破壊した時点を示す. 図から分かる ように高真空になるとともに放出量は減少し、放出量の 最大値に達するまでの時間は長くなる. これは損傷の種 類によらず一般的な傾向とされている. また表面酸化層 の厚さと EE 放出に必要な最低限のひずみの間の関係に ついて、過去の実験結果をまとめたのが図6である³⁰⁾. SUJAK らと BAXTER らでは全く逆の傾向になっているこ とが分かる. この点に関し BAXTER は両者が実験に用い たエッチング液の種類、励起光の波長の差等から説明を 試みているが、それだけでは必ずしも納得できるわけで はない.

図7は引っ張りと圧縮による Cu からの PSEE を示

7



図 7 引っ張りと圧縮にともなう Cu からの PSEE³¹⁾

したものである³¹⁾. 引っ張りの方が圧縮よりも放出量の 増加が大きい. BAXTER らは,引っ張りでは試料表面に すべり帯に沿って清浄な表面が出るが,圧縮では清浄な 面が出にくいためであると説明している.

BROTZEN²⁶⁾らは、引っ張り試験に伴う EE 放出につい て、3.5節の拡散モデルを用い、実験との良い一致を得 ている.

また, SUJAK ら³²⁾は、AI 上に種々の金属を蒸着した 試料を用いて引っ張り試験を行い、AI, Mg を蒸着した 試料ではエキソ電子放出量が増大するが、Ag, Sn, Cu, を蒸着した試料では逆に放出量が押さえられるという結 果を得ている.

WOLLBRANDT³³ らは、LiF, NaF, NaCl 等を圧縮する と数十 keV の高いエネルギーを持った電子が放出され るという結果を報告している. 彼らはこの高エネルギー の原因を、イオン結晶がひずむことにより表面に強い電 場を生じるためと考えている.

4.2 こすり (abrasion)

図8にはステンレス鋼のブラシでこすった Zn を真空 中に置いたとき, Zn からの PSEE が時間的に変化する 様子を示してある³⁴⁾. また表1には Al の場合に PSEE

表 1 圧力の異なる真空中で, こ すった Al が EE 放出最大 に達するまでの時間³⁴⁾

P, µTorr	t _m , s	
50	5	
20	9	
7	35	
4	42	
0, 7	105	

がピークに達するまで の時間 t_m がまとめて ある. 図8と表1を見 ると, Zn で PSEE が 顕著になるためには, Al に比べて圧力の高 い雰囲気が必要である ことが分かる. こすら れた Al に関しては,





図 9 こすった Be からの EE 放出に対する温度の影響5)

引っ張られた場合 (4.1 節) に比べて t_m が小さい. PIMBLEX⁸⁵⁾ らは、こすられた Be, Ca, Al, Mg からの PSEE に対する温度の影響を調べた. 図9は、その結果 である. 曲線(A)はこすってすぐに測定を行ったもの、 (B)はこすってから液体窒素温度に 2260 s 保った後常 温にもどして測定を行ったもの、(C)はこすってから 550°C に 120 s 保った後常温にもどし測定を行ったもの で、(C)の場合 EE は観測されなかった. 温度を下げる と放出が押さえられることから、PIMBLEX らは 3.5 節の 拡散モデルを支持している. 同様な条件で Al に対する 放出量の比は、Be が 1/3、Ca が 2 であった.

4.3 疲労

8

疲労寿命 10 600 回の 1018 鋼からの PSEE と疲労の 関係を図 10 に示す⁹⁾. 横軸は試料表面上のある 直線に



図 10 疲労試験中の 1018 鋼からの EE 放出²⁾



図 11 疲労試験における Al からの EE 放出量の変化い

沿った位置で,縦軸はその位置における放出量である. この際の位置は,ピンホールで径70µmにしぼった励起 光があたる位置を示し,励起光は直線に沿って走査して いる. EE 放出量の測定は,試料が,100,1000,2000, 4000回の繰り返し荷重を受けた時点において行われた. 繰り返し荷重の回数が増すとともに各部からの放出量が 増し,最終的に放出量最大となる点で破壊が生じた.

SMITH³⁶)らは、疲労試験を受ける Al からの EE 放出に 対して表面酸化層の及ぼす影響について調べ、表面酸化 層が厚くなるほど放出量が押さえられるという結果を得 ている.

また VEERMAN¹は、疲労試験中の Alから放出される EE の時間変化を疲労の進行に伴うき裂の成長と関係づ けて、三つのタイプに分けている。即ち、き裂の成長に おいて、I. 遅い、II. 速い、II、停止、という場合に 対応して、EE 放出もそれぞれ、I. ゆっくり増加、II. 急激に増加、II. 変動しながら減少する、という状態を 示す.図 11 に示すように、試料はこの三つの状態を何



図 12 疲労試験における鋼鉄からのエキソ電子放出37)



図 13 クリープ試験にともなう軟鋼からの EE 放出い

度かへて破壊に至るから、放出される EE の時間変動の 状態をつかむことによって、試料が疲労する過程の中で どの時期にあるかを推定できる可能性がある.

また, BAXTER³⁷)は、疲労試験に伴う鋼鉄からのエキ ソ電子放出に関して、疲労を与える前の放出量と、寿命 の2%疲労を与えた時の放出量の間に図 12 に示すよう な直線関係が存在するという結果を得ている.この関係 を用いれば、疲労2%の段階で試料の寿命を推定できる ことになる.

4.4 クリープ

9

クリープ試験に伴う PSEE の測定例を図 13 に示す¹⁾. 試料は棒状の軟鋼(ゲージ長 30mm, 直径 10mm)であ る. 荷重は段階的に増してゆく. つまり, 毎回 100 kgf の荷重が新たに加わるように素早くかける. その時の伸 びと放出される電子数を開 ロ計数管(計数ガス: CH₄) で 10 秒毎に最低 10 回記録している. 実線が放出量, 破 線が伸びを表す.荷重をかける毎に放出量は急激に増大 し、ピークを経て減少するが,荷重を増した際の放出量 は毎回増加し,それは破壊が生じるまで続く.

5. 結 び

以上, 主として金属について, それが機械的に変形さ れたり損傷を受けたりしたとき、放出される EE がどの よらな挙動を示すかという点に照明をあてて述べてきた。 EE の放出機構についてはまだ解明されていない点は多 いが、最近の技術の進歩に伴い、 EE 測定も良くコント ロールされた条件下で行うことが可能となってきたので 希望は残されている. 例えば, 超高真空中で種々の分析 装置を用いながら試料表面を制御し、吸着ガスや表面構 造の EE への影響を詳しく調べるといった研究がそれで ある. こらした実験条件が整い信頼できる基礎データの 積み重ねが、放出機構を真に明らかにするために強く望 まれている. この解説では、EE の放出量だけに着目し た研究を紹介してきたが、最近の傾向として、 PSEE に おいても、エネルギー分析に重点を置いた実験が行われ 始めた. Ar スパッタした Al, Mg, Al-Mg 合金の初期 酸化に関する研究38)や、AI単結晶の疲労に関する研 究30)にその例が見られる.

EE については奇妙なことに, 基礎的な放出機構その ものが十分に明らかでないにもかかわらず, 応用的な研 究がむしろ進んでいることを最後にコメントしておこう. 例えば, EE を利用した顕微鏡^{40~42)}や放射線量計⁴³⁾の開 発があげられる.

文 献

- C. C. VEERMAN: Materials Sci. Engineering, 4, (1969) 329.
- W. J. BAXTER: J. Appl. Phys., 44, (1973) 608.
- 3) D.R. ARNOTT & J.A. RAMSEY : Surf. Sci., 28, (1971) 1.
- J. KRAMER : Z. Physik, 125, (1949) 739.
- 5) J.W.RUSSEL : Proc. Roy. Soc., 61, (1897) 424.
- 6) M. TANAKA : Phys. Rev., 48, (1935) 916.
- W. B. LEWIS & W. E. BURCHAM : Cambridge Proc. Phil. Soc., 32, (1936) 503.
- A. SCHARMANN: Proc. 4 th Intern. Symp. on Excelectron Emission and Dosimetry, held at Liblice (1973) 12.

- 9) G. HOLZAPFEL : Phys. Stat. Sol., 33. (1969) 235.
- 10) P.KELLY : Phys. Rev. B, 5, 2 (1971) 749.
- 11) L. WOLBER : Phys, Stat. Sol., (a) 24, (1974) K75.
- V. S. KORTOV & P. P. ZOLNIKOV : Phys, Stat. Sol., (a) 31, (1975) 331.
- 13) J. KRAMER : Z. Phys., 729 (1951) 34.
- 14) J. LEPPER : Z. Naturtorsch Loa, (1955) 47.
- A. BOHUN & CZECH : J. Phys., 5 (1955) 224, 429, 6 (1956) 141.
- 16) G.GOURGE & W.HANLE: Acta. Phys. Austr., 10 (1957) 429.
- 17) P. GORDON & A. SCHARMAN : Z. Phys., 146, (1956) 1.
- 18) A. BOHUN & CZECH : J. Phys., 5 (1955) 146.
- H. F. KÄÄMBRE, A. BOHUN & CZECH : J. Phys., B 14, (1964) 54.
- 20) V. B. CHEIRN & H. KÄÄMBRE : Phys. Stat. Sol., (a) 4, (1971) K235.
- 21) E.I. TOLPYGO, K.B. TOLPYGO, M.K. SHEINKMAN & BULL: Acad. of Sci. USSR, 30, (1966) 1980.
- 22) B. SUJAK : Acta. Phys. Pol., 20 (1961) 969.
- 23) J. DRENCKHAM, H. GROSS & H. GLAEFEKE : Phys. Stat. Sol.,
 (a) 2, (1970) K51. (a) 3, (1970) K185.
- 24) M. SCHMICLT, H. GLAETEKE, J. DRENCKJA & W. WILD: Racl. Effects, 17, (1973) 185.
- A. GIEROSZYNSKY & B. SUJAK: Acta. Phys. Polon., 28, (1965) 337, 29, (1966) 533.
- 26) W. D. Von Voss & F. R. BROTZEN: J. Appl. Phys., 30, 11 (1959) 1639.
- 27) W.T.PIMBLEY & E.E.FRANCIS: J.Appl. Phys., 32, 9 (1961) 1729.
- 28) R. N. CLAYTOR & F. R. BROTZEN : J. Appl. Phys., 36, 11 (1965) 3549.
- 29) D. R. ARNOTT & J. A. RAMSEY : Surt. Sci., 28, (1971) 1.
- 30) W.I. BAXTER & S.R. ROUZE : J. Appl. Phys., 49, 7 (1978) 4233.
- 31) W. J. BAXTER : J. Appl. Phys., 45, 1 (1974) 4692.
- 32) B. SUJAK, A. GIEROSZYNSKI & K. GIEROSZYNSKI : Acta. Phys. Pol., A 48, (1975) 3.
- 33) J. WOLLBRANDT, E. LINKE & K. METER : Phys. Stat. Sol., (2) 27 (1975) K53.
- 34) J.A. RAMSEY : J. Appl. Phys., 37, (1966) 452.
- 35) T.C. KU & W.T. PIMBLEY : J. Appl. Phys., 32 (1961) 124.
- 36) T. SMITH & D.O. THOMPNSO: Proc. th Intern. Symp. on Excelectron Emission and Dosimetry, Held at Liblice (1973) 32.
- W. J. BAXTER : Metallurgical Transactions A, 6A, (1975) 749.
- 38) G.C. ALLEN & P.M. JUCKEN : Surf. Sci., 102 (1981) 207.
- 39) T.K.G. SWAMI & Y.W. CHUNG : Surf. Sci., 99, (1980) 373.
- 40) S. YAMAMOTO: J. J. Appl. Phys., 20 (1981) 971.
- 41) 山本茂之:真空, 24, 9 (1981) 495.
- 42) 斎藤安俊,他:真空,24,9 (1981) 502.
- 43) 川西政治:応用物理, 49, 2 (1979) 94.